



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

**SOD-123 封装二极管/SOD-123 Plastic-Encapsulate Diodes**

## 1N4448W (FAST SWITCHING DIODE)

### 特点/Features :

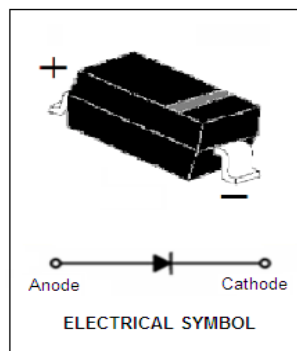
- 速度快 ;
- 反向阻抗高 ;
- 尺寸小 , 适合各种有尺寸要求场合 ;

### 用途/Applications :

高速开关电路。

### 印章/ Marking: T5

### 极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)



参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
反向峰值电压/Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RM}$	100	V
反向峰值电压/ Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	75	V
反向工作峰值电压/Working Peak Reverse Voltage	$V_{RWM}$	75	V
直流阻断电压/DC Blocking Voltage	$V_R$	75	V
最大反向电压有效值/RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	53	V
正向连续电流/Forward Continuous Current	$I_{FM}$	500	mA
平均整流输出电流/Average Rectified Output Current	$I_o$	250	mA
正向瞬间峰值电流/Peak Forward Surge Current	$I_{FSM}$	4 (@=1.0μS)	A
		1.5 (@=1.0S)	
功率/ Power Dissipation	$P_D$	0.5	W
热阻/Thermal Resistance Junction to Ambient Air	$R_{\theta JA}$	250	°C/W
结温/Junction Temperature	$T_j$	125	°C
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	°C

### 电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数/Parameter	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
反向击穿电压/ Reverse Breakdown Voltage	$V_{(BR)}$	$I_R=10 \mu A$	75		V
正向电压/Forward Voltage	$V_{F1}$	$I_F=5mA$	0.62	0.72	V
	$V_{F2}$	$I_F=10mA$		0.855	V
	$V_{F3}$	$I_F=100mA$		1	V
	$V_{F4}$	$I_F=150mA$		1.25	V
反向漏电流/Reverse Current	$I_{R1}$	$V_R=75V$		2.5	$\mu A$
	$I_{R2}$	$V_R=20V$		25	nA
端电容/Capacitance Between Terminals	$C_T$	$V_R=0, f=1MHz$		4	pF
反向恢复时间/Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F=I_R=10mA, R_L=100 \Omega$ $I_{rr}=0.1 \times I_R,$		4	nS



### 典型特性曲线图/Typical Characteristics

